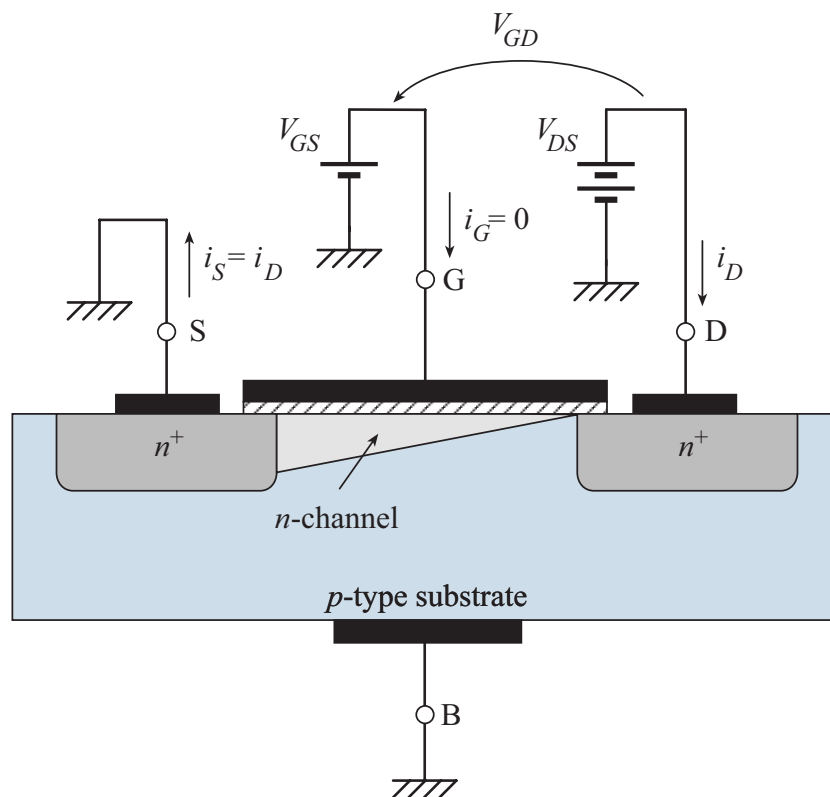


Struttura del canale di un transistor NMOS ad arricchimento per valori elevati della tensione V_{DS} . La sezione del canale diventa non uniforme e la sua resistenza aumenta al crescere di V_{DS} . In questo caso la tensione V_{GS} è mantenuta costante ad un valore $V_{GS} > V_{TH}$.



Struttura del canale di un transistor NMOS ad arricchimento per $V_{GD} = V_{TH}$, ovvero per $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$: la larghezza del canale si annulla in prossimità del *drain*. Tale condizione è detta di "strozzamento" del canale, o di *pinch-off*.